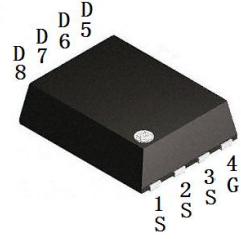


## LYNM7414D2P (LYNM7414DP) (进口芯片)型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

### 特性

- 参照执行标准：QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式：DFN-3.3
- 开关速度快，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好



DFN-3.3

### 极限参数

- 贮存温度  $T_{stg}$ :  $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度  $T_{amb}$ :  $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过  $260^{\circ}\text{C}$ ，焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 $P_D$ (W)	漏源电压 $BV_{DSS}$ (V)	栅源电压 $V_{GS}$ (V)	漏极电流 $I_D$ (A)	导通电阻 $R_{DS}$ ( $m\Omega$ )	热阻 $R_{th(j-c)}$ (K/W)
LYNM7414D2P (LYNM7414DP)	31 ( $T_c=25^{\circ}\text{C}$ )	60	$\pm 20$	8.7 ( $T_c=25^{\circ}\text{C}$ )	56	4.0

### 主要电特性 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	60	—	—	V
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$	—	—	1	$\mu A$
正向栅极漏电流	$I_{GSSF}$	$V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	$I_{GSSR}$	$V_{GS}=-20V, V_{DS}=0V$	—	—	-100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2.0	—	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=10V, I_D=4A$	—	—	56	$m\Omega$
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=6V, I_D=3A$	—	—	90	$m\Omega$
跨导	$g_{FS}$	$V_{DS}=10V, I_D=4A$	4	—	—	S
电容	$C_{ISS}$	$V_{DS}=50V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	—	—	402	pF
	$C_{OSS}$	$V_{DS}=50V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	—	—	96	pF

### DFN-3.3 封装外形图

